Also published as:

] JP4124383 (B2)

SHOWER PLATE, SHOWER PLATE PERIPHERAL STRUCTURE, AND PROCESSOR

Publication number: JP11297672 (A)

Publication date: 1999-10-29

Inventor(s):

OMI TADAHIRO; NITTA TAKEHISA; HIRAYAMA MASAKI; MORII AKIO

Applicant(s):

OMI TADAHIRO; ULTLA CLEAN TECHNOLOGY KAIHATS

Classification:

- international:

H01L21/302; H01L21/205; H01L21/3065; H01L21/02; (IPC1-

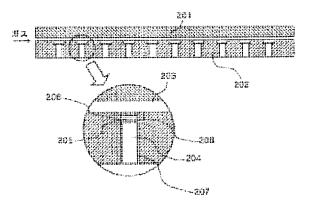
7): H01L21/3065; H01L21/205

- European:

Application number: JP19980097978 19980409 **Priority number(s):** JP19980097978 19980409

Abstract of JP 11297672 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a shower plate, in which an outlet can be readily formed regardless of a material and it is possible to prevent plasma from being ignited at a gap between the shower plate and a gap plate placed thereon, when the shower plate is used for a microwave excitation plasma device. SOLUTION: A blow outlet port 207 is constituted by holes formed on a plate 202, and spaces formed between the holes and circular cylinders 204, which have smaller diameters than the holes. Furthermore, the outlet 207 has a tapered shape, the shower plate 202 is made of a dielectric material, and the shower plate 202 is disposed for a microwave excitation plasma device.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-297672

(43)公開日 平成11年(1999)10月29日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号

FΙ

H 0 1 L 21/3065 21/205

H01L 21/302 21/205 В

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 9 頁)

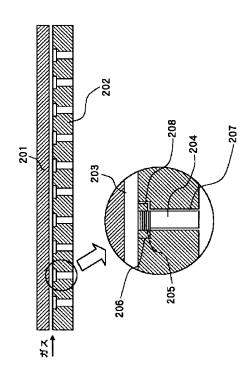
| (21)出願番号 | 特顯平10-97978 | (71)出願人 | 000205041 |
|----------|------------------|---------|---------------------|
| | | | 大見 忠弘 |
| (22)出顧日 | 平成10年(1998) 4月9日 | | 宮城県仙台市青葉区米ケ袋2—1—17— |
| | | | 301 |
| | | (71)出職人 | 596089517 |
| | | | 株式会社ウルトラクリーンテクノロジー開 |
| | | | 発研究所 |
| | | | 東京都文京区本郷4-1-4 |
| | | (72)発明者 | 大見 忠弘 |
| | | | 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋2の1の17の |
| | | | 301 |
| | | (74)代理人 | 弁理士 福森 久夫 |
| | | | |
| | | | 最終頁に続く |

(54) 【発明の名称】 シャワープレート、シャワープレート周辺構造及びプロセス装置

(57)【要約】

【課題】 材料に関わりなく吹出口の形成が容易なシャ ワープレートを提供すること。マイクロ波励起プラズマ 装置に用いた場合、シャワープレートとその上に載せる 隙間板とのギャップにおいてプラズマが着火するのを防 ぐことが可能なシャワープレートを提供する。

【解決手段】 吹出口207は、プレート202に開け られた孔と、孔に挿入された孔よりも小さな径を有する 円柱204との間に形成される空間により形成されてい ることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ブレートに複数の吹出口を有するシャワ ープレートにおいて、該吹出口は、該プレートに開けら れた孔と、該孔に挿入された該孔よりも小さな径を有す る円柱との間に形成される空間により形成されていると とを特徴とするシャワープレート。

1

【請求項2】 該吹出口をテーパー状にしたことを特徴 とする請求項1記載のシャワープレート。

【請求項3】 該シャワープレートは誘電体材料からな ることを特徴とする請求項1または2記載のシャワープ 10 レート。

【請求項4】 該シャワーブレートはマイクロ波励起ブ ラズマ装置用であることを特徴とする請求項1乃至3の いずれか1項記載のシャワープレート。

【請求項5】 側面に開口する入口と、中央部において 上面側に開口する出口と、該入口と該出口とを連通し、 内部に形成された通路とからなるガス導入路が形成され ていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項 記載のシャワープレート。

【請求項6】 プレートに複数の吹出口を有するシャワ 20 ープレートと、

該シャワープレートの上方に、シャワープレートとの間 でギャップを形成して配置された隙間板と、

該ギャップ内にプロセスガスを導入するためのガス導入 路と、を有するシャワープレート周辺構造において、 該シャワープレートの側面に開口する入口と、シャワー プレート中央部において該ギャップ側に開口する出口 と、該入口と該出口とに連通し、該シャワープレート内 部に形成された通路とにより該ガス導入路が構成されて いることを特徴とするシャワープレート周辺構造。

【請求項7】 該シャワープレートは誘電体材料からな ることを特徴とする請求項6記載のシャワープレート周 辺構造。

【請求項8】 プレートに複数の吹出口を有するシャワ ープレートと、

該シャワープレートの上方に、シャワープレートとの間 でギャップを形成して配置された隙間板と、

該ギャップ内にプロセスガスを導入するためのガス導入 路と、を有するシャワープレート周辺構造において、

数個設けたことを特徴とするシャワープレート周辺構 造。

【請求項9】 該シャワープレートの上面に複数の突起 を高さが同一となるように形成し、該突起をスペーサー としたことを特徴とする請求項8記載のシャワープレー

【請求項10】 請求項1乃至5のいずれか1項記載の シャワープレートを用いたプロセス装置。

【請求項11】 請求項6乃至9いずれか1項記載のシ ャワープレートを用いたプロセス装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、シャワープレート、シ ャワープレートの周辺構造及びプロセス装置に係る。よ り詳細には、大型基板上への均一なプロセスガス供給が 可能なシャワープレート、シャワープレート周辺構造及 びそれを用いたプロセス装置に関する。

[0002]

【関連する技術】従来、シャワープレート、その周辺構 造については以下のような技術が知られている。

- (1)直径0.1 μ m程度の多数の小さな孔(吹出口) 104を垂直または斜めにあけたシャワープレート(図 1)をウェーハ直上に設けて、そのシャワープレート1 02からガスをプロセス空間に供給する技術。
- (2)シャワープレート102にあけた孔(吹出口)1 04にガスを送るのに、シャワープレート102の上に 1mm程度のギャップ103を空けて隙間板101を置 き、シャワープレート102と隙間板101との間のギ ャップ103に側面からガスを流し込む技術。
- (3)マイクロ波プラズマプロセス装置の場合、マイク 口波の吸収の少ないセラミックス等の材料を用いた直径 0.5mm程度の多数の孔をあけ、(2)の技術を用い たシャワープレートをマイクロ波導入部に設ける技術。 【0003】しかし、上記従来技術には、次のような問 題がある。
- 1. (1)の技術では、小さい穴加工が可能なSiやA 1などに材料が限定され、マイクロ波を透過するセラミ ックスなどには加工ができなかった。例えばアルミナの 板にO. l μ m の孔 l O 4 をあける場合、その深さの限 30 界は 0.2 μ m 程度である。また小さな孔の場合、真っ 直ぐにかつ孔104の内面を鏡面仕上げしてあけること が技術的に困難であった。

【0004】2. (1)の技術では、各孔104から等 しくガスが吹き出すように各孔104にガスを送るギャ ップ103とプロセス室との間の圧力差を大きくする必 要があるが、そのために孔104から勢いよくガスが噴 き出して孔104の配列パターンの不均一を生じること

【0005】3. (2)の技術では、プロセスガス流量 該隙間板と該シャワープレートとの間にスペーサーを複 40 を減らした場合等に、側面のガスを流し込む場所に近い 孔104からより多くのガスが吹き出すために、プロセ ス空間にガスの不均一が生じていた。この傾向は処理す るウェーハが200mm、300mmと大口径化するに 従い顕著になっている。

> 【0006】4. (3)の技術では、マイクロ波励起の プラズマがプロセス空間ではなく、シャワープレート 1 02とその上に載せる隙間板101との間のガスを広げ る空間に着火することがあった。

[0007]

50 【発明が解決しようとする課題】本発明は、材料に関わ

3 りなく吹出口の形成が容易なシャワープレートを提供す ることを目的とする。

【0008】マイクロ波励起プラズマ装置に用いた場 合、シャワープレートとその上に載せる隙間板とのギャ ップにおいてプラズマが着火するのを防ぐことが可能な シャワープレートを提供することを目的とする。

【0009】また、吹出口の配列パターンの不均一のな いシャワープレートの周辺構造を提供することを目的と する。

吹き出し量のチャンバーの中心軸に対し軸対称性が保つ ことができるシャワープレート周辺構造を提供すること を目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明のシャワープレー トは、プレートに複数の吹出口を有するシャワープレー トにおいて、該吹出口は、該プレートに開けられた孔 と、該孔に挿入された該孔よりも小さな径を有する円柱 との間に形成される空間により形成されていることを特 徴とする。

【0012】本発明では、吹出口は、プレートに開けた 孔自体により構成されるのではなく、孔と孔に挿入され た円柱との間に形成される空間により構成される。従来 は孔の径はO. 1μm程度であったが、本発明では、m mのオーダーで孔を開ければよいため、孔開け加工の困 難なセラミックス (誘電体材料) などであっても容易に 加工することが可能である。従って、誘電体材料により シャワープレートを製造することが可能となり、誘電体 材料からなるシャワープレートをマイクロ波励起プラズ マ装置に用いれば、シャワープレートとその上に載せる 30 隙間板とのギャップにおいてブラズマが着火するのを防 ぐことが可能となる。

【0013】なお、吹出口をテーパー状にすればガスの 吹出をより均一にすることができる。

【0014】本発明のシャワープレートは、プレートに 複数の吹出口を有するシャワープレートと、該シャワー プレートの上方に、シャワープレートとの間でギャップ を形成して配置された隙間板と、該ギャップ内にプロセ スガスを導入するためのガス導入路と、を有するシャワ 面に開口する入口と、シャワープレート中央部において 該ギャップ側に開口する出口と、該入口と該出口とに連 通し、該シャワープレート内部に形成された通路とによ り該ガス導入路が構成されていることを特徴とする。

【0015】本発明のシャワープレート周辺構造は、プ レートに複数の吹出口を有するシャワープレートと、該 シャワープレートの上方に、シャワープレートとの間で ギャップを形成して配置された隙間板と、該ギャップ内 にプロセスガスを導入するためのガス導入路と、を有す るシャワープレート周辺構造において、該隙間板と該シ 50 溝を作ってギャップを設けても良い。また孔側の一部分

ャワープレートとの間にスペーサーを複数個設けたこと を特徴とする。

[0016]

【実施例】以下に本発明の実施例を図面に基づいて説明 する。なお、本発明範囲は以下の実施例に限定されるも のではない。

【0017】(実施例1)図2に本実施例を示す。本実 施例のシャワープレートは、吹出口207は、プレート 202に開けられた孔と、孔に挿入された孔よりも小さ 【0010】また、ガス流量を減らした場合にもガスの 10 な径を有する円柱204との間に形成される空間により 形成されている。

> 【0018】以下本実施例をより詳細に説明する。図2 に示す200mmウェーハプロセス用のシャワープレー トを作製した。直径350mm、厚さ20mmのシャワ ープレート202の中央直径200mmの範囲に、20 mm間隔で孔加工した。直径2.1mmの孔をあけ、孔 の上部は雌ネジ206を挿入するため2mmの深さで直 径6mmに広げた。

【0019】一方、円柱204は直径2.0mmとし、 20 その先端には雄ネジ205を形成した。

【0020】円柱204を孔に挿入し、雌ネジ206で 固定した。なお、雌ネジ206には切り欠き208が入 れてあり、この切欠208をガスの通り道とした。

【0021】 このシャワープレート202の上に1mm のギャップ203を空けて板201を置き、シャワープ レート側面から導入したガスがこの1mmのギャップ2 03を広がり各吹出口207にガスが供給されるように

【0022】シャワープレート202、円柱204、雌 ネジ206、および上に載せる隙間板201にはアルミ ニウムを用いた。

【0023】図5に示す測定系を用いてシャワーブレー トの各吹出口のコンダクタンスを測定した。各吹出口の 入口及び出口にガスラインを固定し、流量コントローラ -504で一定量の空気を流し、真空ポンプ507で排 気した。排気速度はコンダクタンスバルブ506で調整 した。

【0024】2つの圧力計505の指示する圧力の平均 値を横軸に、そのときの流量及び排気速度から計算され ープレート周辺構造において、該シャワープレートの側 40 る孔のコンダクタンスを横軸にとったデータを図6に示 す。図には比較のため、直径0.5mmの孔のデータも 載せた。設計寸法から計算されるコンダクタンスにほぼ 等しいコンダクタンスが得られていることが確認され た。エッチングプロセスでの典型的なチャンバー圧力2 OmTorrでのコンダクタンスの吹出口間のばらつき は、従来の孔で10%あるのに対し、本発明の構造では 5%とばらつきが小さくなっていることが確認された。 【0025】上記実施例では、孔にそれより小さな円柱 を挿入したが、ほぼ同じ直径の円筒の一部分を削るか、

に溝を設けても良い。ギャップを0.1mmとしたが、 これはプロセス圧力、流量等のプロセス条件に応じて必 要なコンダクタンスになるよう設計すれば良い。材料は アルミニウムを用いたがこれに限る必要は無く、銅、ス テンレス鋼、Siやアルミナ、窒化アルミニウム等のセ ラミックスを用いても良い。

【0026】(実施例2)本例では、実施例1の加工に 加えて、図3に示すように、吹出口のガス吹き出し口側 に45度のテーパー構造を持たせた。すなわちシャワー プレート側はガス吹き出し口側5mmを円錐状に広げ、 挿入する円柱は下側5mmに円錐を付けた形にした。テ ーパー部の隙間は0.5mmと大き目にし、吹出口30 7のコンダクタンスは円柱304部の隙間0.5mmで 絞るようにした。

【0027】とのシャワープレートを図7に示す、20 0 mmウェーハ対応のダイポールリングマグネットを用 いた高周波励起平行平板型マグネトロンエッチング装置 に取り付けて、5000sccmのアルゴン、四塩化フ ッ素混合ガスを流し、13.56MHz、1000Wの 高周波電力をウェーハステージに投入して、200mm 20 □径のシリコン酸化膜付きのウェーハ704のエッチン グを行った。ガスは配管702を通してシャワープレー ト側面から導入した。

【0028】高周波電源709はブロッキングコンデン サー708を介してウェーハステージに接続した。チャ ンバー壁706の外側にはチャンバーを取り囲むように ダイポールリングマグネット705を設置した。シャワ ープレートとウェーハの距離が20mmの場合、図1に 示す従来のシャワープレートでは、孔の配列パターンに エッチング速度分布が生じたが、本発明の図3に示すシ 30 ャワープレートを用いた場合はこうした分布は観察され なかった。

【0029】(実施例3)図4に本実施例を示す。本実 施例のシャワープレート周辺構造は、プレートに複数の 吹出口(図示せず)を有するシャワープレート402 と、シャワープレート402の上方に、シャワープレー ト402との間でギャップ403を形成して配置された 隙間板401と、ギャップ403内にプロセスガスを導 入するためのガス導入路と、を有するシャワープレート □する入□405と、シャワープレート中央部において ギャップ403側に開口する出口406と、入口405 と出口406とに連通し、シャワープレート402内部 に形成された通路404とによりガス導入路が構成され ている。

【0030】以下本実施例をより詳細に説明する。本例 では、実施例2の加工に加えて、シャワープレート40 2の各吹出口(図示せず)にガスを送るシャワープレー ト402とその上の隙間板401板とのギャップ403 へのガス供給において、図4に示すようにシャワープレ 50 プレートに載せる板に付けてもよいし、スペーサーを置

ート402の側面から中央部に通じる直径3mmの通路 404をあけて、シャワープレート402の中央からギ ャップ403にガスが供給されるようにした。

【0031】とのシャワープレートを図7の200mm ウェーハ対応のダイボールリングマグネットを用いた高 周波励起平行平板型マグネトロンエッチング装置に取り 付けて、実施例2に示したのと同じエッチングプロセス を行った。プロセスガス流量を100sccmに減らし た場合、実施例2のシャワープレーとではガス供給口側 10 からガスが多く吹き出し、その部分のエッチング速度が 高くなった。本例のシャワープレートでは、出口406 のある中央部がエッチング速度が高くなったが、分布は 点対称であり、中央部と周囲部とのエッチング速度の差 は、実施例2のシャワープレート402での出口406 側とその反対側との差と比べて小さくなっていることが 確認された。

【0032】(実施例4)本例では、実施例3に加え、 さらに図8に示すようにシャワープレートの上部に突起 801を吹出□803のない部分に設けて、シャワープ レートの上に板804を載せた時にこの突起が隙間板8 04に当たるためギャップの高さが面内で均一になるよ うにした。

【0033】さらにこのシャワープレートをマイクロ波 プラズマに用いる場合に、そのスペーサーの表面でブラ ズマが損失するためギャップでのプラズマ着火が起こり にくいようにした。シャワープレートとその吹出口、お よびシャワープレートの上に載せる隙間板804は、マ イクロ波をよく透過するアルミナを用いた。シャワープ レート上部の突起は1mm角、高さ1mmとした。

【0034】とのシャワープレートを図9に示すラジア ルラインスロットアンテナを用いた2.45GHzマイ クロ波励起プラズマ装置のマイクロ波導入部に設置し、 マイクロ波を投入した時にシャワープレートのギャップ にプラズマが着火するかどうか調べた。マイクロ波は同 軸同波管906を通ってラジアルラインスロットアンテ ナ905に供給され、マイクロ波はこのアンテナ905 から平面波としてチャンバーに供給される。プラズマ9 03はシャワープレート901とウェーハ904の間の プロセス空間に発生する。

周辺構造において、シャワープレート402の側面に開 40 【0035】図10に、ギャップ内でプラズマが着火す る最小マイクロ波電力のギャップ圧力依存性を示す。本 例のシャワープレート上部に突起を設けて、上に載せる 隙間板804とのスペーサーとした場合、スペーサーが 無い時と比べてギャップ内でプラズマが着火する電力が 大きくなっていることから、本例の構造がギャップ内で プラズマを着火しにくくする効果が確認された。

> 【0036】上記実施例ではアルミナを用いたが必ずし もアルミナを用いる必要はなく、例えば窒化アルミニウ ムや窒化シリコンを用いても良い。また突起はシャワー

いてもよい。また形状は正方形を碁盤の目状に並べたも のに限らず、螺旋状や同心円と放射線の組み合わせなど の形状で溝を掘っても構わない。

[0037]

【発明の効果】本発明によれば次の諸々の効果が達成さ れる。材料に関わりなく吹出口の形成が容易である。

【0038】マイクロ波励起プラズマ装置に用いた場 合、シャワープレートとその上に載せる隙間板とのギャ ップにおいてプラズマが着火するのを防ぐことが可能で ある。吹出口の配列バターンの不均一を無くすことがで 10 101、201、401 隙間板、 きる。

【0039】ガス流量を減らした場合にもガスの吹き出 し量のチャンバーの中心軸に対し軸対称性が保つことが できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の真っ直ぐな孔のガス吹き出し口を有する シャワープレートの断面図である。

【図2】実施例1に係る、大き目の孔に円柱を挿入した ガス吹き出し部を有するシャワープレートの断面図であ

【図3】実施例2に係る、大き目の孔に円柱を挿入した ガス吹き出し部で吹き出し先端がテーパー状に広がった 構造を有するシャワープレートの断面図である。

【図4】実施例3に係る、シャワープレート側面から中 央上部に通じる孔をあけることにより、シャワープレー トの各孔にガスを送るギャップへガスを導入する部分を シャワープレートの中央に有するシャワープレートの断 面図である。

【図5】実施例1に係る、シャワープレートの各孔のコ ンダクタンスの測定系の概念図である。

【図6】実施例1に係る、シャワープレートの孔のコン ダクタンスの設計値と実測値の一例を示すグラフであ

【図7】実施例1から3に係る、図1から3を取り付け ることが可能な、ダイボールリングマグネットを用いた 髙周波励起平行平板型マグネトロンエッチング装置の概 念図である。

【図8】実施例4に係る、シャワープレートの各孔にガ スを送るギャップ部分を、シャワープレートの上部に縦

横の溝を設けて、その上に別の板を載せることによって 形成したシャワープレートである。

【図9】実施例4に係る、図8の構造を有するシャワー プレートを取り付けたラジアルラインスロットアンテナ を用いたマイクロ波励起プラズマ装置の概念図である。 【図10】実施例4に係る、図9のプラズマ装置を用い

て測定した、ギャップ内でのプラズマ着火が起こる最小 マイクロ波電力の圧力依存性を示すデータである。

【符号の説明】

102、202、402 シャワープレート、

103、203、403 ギャップ、

104、207、307 吹出口、

204、304 円柱、

205 雄ネジ、

206 雌ネジ、

208 切欠、

404 通路、

405 入口、

20 406 出口、

504 流量コントローラー、

505 圧力計、

506 コンダクタンスバルブ、

507 真空ポンプ、

704 ウェーハ、

702 配管、

705 ダイポールリングマグネット、

706 チャンバー壁、

708 ブロッキングコンデンサー、

30 709 高周波電源、

801 突起、

803 吹出口、

804 隙間板、

901 シャワープレート、

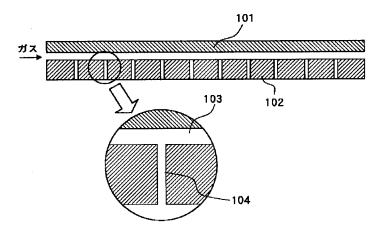
903 プラズマ、

904 ウェーハ、

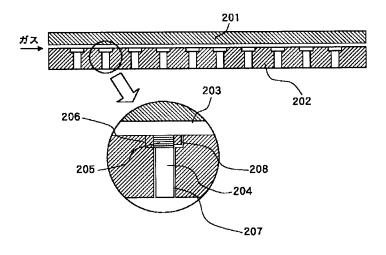
905 ラジアルラインスロットアンテナ、

906 同軸同波管。

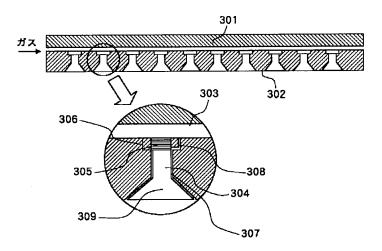
【図1】



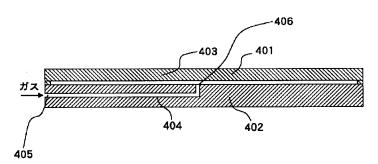
【図2】



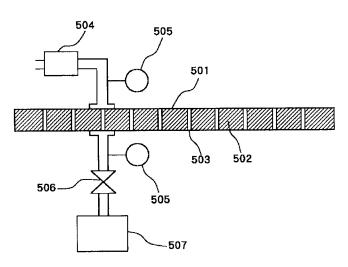
【図3】



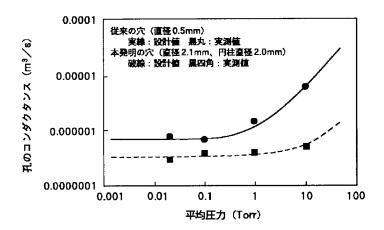
【図4】



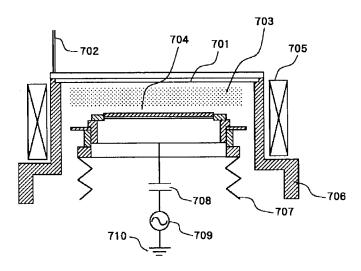
【図5】



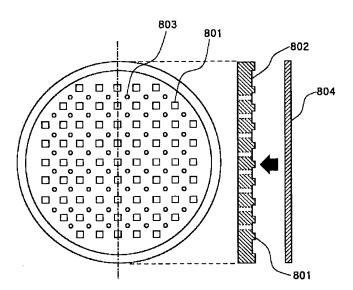
【図6】



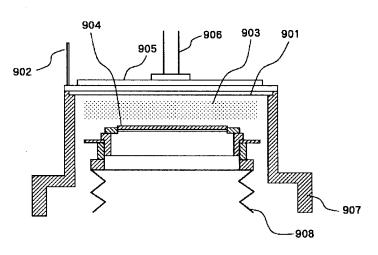
【図7】



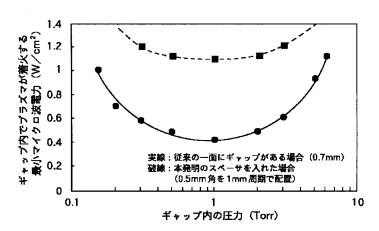
【図8】







【図10】



フロントページの続き

(72)発明者 新田 雄久

東京都文京区本郷4丁目1-7 株式会社 ウルトラクリーンテクノロジー開発研究所 内 (72)発明者 平山 昌樹

宫城県仙台市青葉区荒巻字青葉 (無番地)

東北大学内

(72)発明者 森井 明雄

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉(無番地)

東北大学内